

# УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 2010 г.

## Техническая политика

Обзор результатов работ по развитию конкурентоспособных направлений микроэлектроники, выполненных в 2007—2009 гг. в рамках Государственной программы. *Падалко В. Г., Николаенко Ю. Е., Высоцкий А. Н., Кончиц Н. В.* 2

## Современные электронные технологии

Модуль солнечных батарей на основе соединений  $A_3B_5$  с концентраторами солнечной энергии и системой теплоотвода. *Вакив Н. М., Круковский С. И., Николаенко Ю. Е., Круковский Р. С., Тимчишин В. Р., Сыворотка Н. Я.* 2

Выбор предпочтительных слоев для проводников при трассировке многослойных печатных плат. *Петросян Г. С., Полубасов О. Б.* 2

## Новые компоненты для электронной аппаратуры

Фотодиод ультрафиолетового диапазона на основе селенида цинка. *Перевертайло В. Л., Добровольский Ю. Г., Попов В. М., Поканевич А. П., Мацкевич В. М., Рыжиков В. Д., Шабашкевич Б. Г., Юрьев В. Г.* 2

Перестраиваемая линия задержки сигнала СВЧ-диапазона на основе сегнетоэлектрических и алмазных пленок. *Афанасьев М. С., Митягин А. Ю., Чучева Г. В.* 3

Конденсаторы на основе интеркалата GaSe  $\langle KNO_3 \rangle$ . *Ковалюк З. Д., Коноплянко Д. Ю., Нетьяга В. В., Бахтинов А. П.* 3

Диоды Ганна из InP с катодным контактом, инжектирующим горячие электроны. Часть 1. Межфазные взаимодействия в катодных контактах. *Болтовец Н. С., Иванов В. Н., Ковтонюк В. М., Раевская Н. С., Беляев А. Е., Бобыль А. В., Конакова Р. В., Кудрик Я. Я., Миленин В. В., Новицкий С. В., Шеремет В. Н.* 5-6

## Электронные средства: исследования, разработки

Эффект усиления фототока в фотодиодной структуре с прямо- и обратновключенными переходами. *Ёдгорова Д. М.* 1

Специализированное устройство электропитания. *Гунченко Ю. А., Банзак О. В., Селюков А. В., Куташев В. И.* 1

Радиоволновое охранное устройство на излучающем кабеле. *Прудюс И. Н., Проць Р. В., Сторож В. Г.* 1

Особенности стирания информации с многодисковых винчестеров импульсным магнитным полем. *Герус С. В., Митягин А. Ю., Соколовский А. А., Темирязева М. П., Хлопов Б. В.* 1

Оценка структурной избыточности БИС с помощью помехоустойчивой кластеризации. *Щербакова Г. Ю.* 1

Оптимальный выбор стандартных несущих конструкций для электронных средств. *Ефименко А. А., Вильчинский А. И.* 2

Устройство формирования элементов оптоэлектронной акустооптической вычислительной среды. *Липинский А. Ю., Рудякова А. Н., Рудяков И. Ю., Данилов В. В.* 3

Лазерные устройства для измерения геометрических параметров трехмерных объектов. *Ильин В. Н., Дубешко А. В., Михаевич Д. А.* 3

Цифровой метод измерения коэффициента направленного отражения поверхности. *Иванченко И. А., Сантоний В. И., Смынтына В. А.* 3

Экспериментальное доказательство экситонно-плазменного фазового перехода Мотта. *Гаркавенко А. С.* 3

Моделирование электрических схем защиты с использованием силовых лавинных диодов. *Кравчина В. В., Нагорная Н. Н.* 4

Малогобаритный цифровой частотомер с высокой разрешающей способностью. *Криваль И. И., Скрипнюк А. И., Проценко В. А., Марьенко А. В.* 4

Контактные соединения в электронных печатных узлах, выполненные методом прокола фольги. *Ефименко А. А.* 4

Тепловизор на основе матричного фотоприемного устройства из  $128 \times 128$  CdHgTe-фотодиодов. *Рева В. П., Голенков А. Г., Забудский В. В., Коринец С. В., Цибрий З. Ф., Гуменюк-Сычевская Ж. В., Бунчук С. Г., Апатская М. В., Лысюк И. А., Смолий М. И.* 4

Метод преобразования обычной разводки печатных плат в полигональную. *Муров С. Ю.* 4

Логические методы расчета надежности. *Левин В. И.* 4

Методика диагностики электронных пучков среднего уровня мощности по переходному излучению. *Воробьев Г. С., Дрозденко А. А., Шульга Ю. В., Барсук И. В.* 5-6

Повышение надежности контакта тонкопленочных резисторов. *Лугин А. Н., Оземша М. М.* 5-6

Оценка частотной границы допустимого использования приближенных моделей линий передачи при анализе цепей печатных плат. *Сиротко В. К.* 5-6

Автодинный спектрометр ядерного квадрупольного резонанса с равномерной частотной шкалой. *Самила А. П., Хандожко А. Г., Хандожко В. А.* 5-6

**Системы передачи и обработки сигналов**

Способ искажения информации о радиолокационных характеристиках объектов. *Василевский В. В., Головань В. Г., Головань А. В., Дроздов М. А., Хижняк Т. А.*

2

Многоканальные устройства цифровой обработки сигналов с ранжированной архитектурой. *Баранов П. Е., Шейк-Сейкин А. Н.*

3

**Микропроцессорные устройства и системы**

Микропроцессоры звездообразной структуры с расширенными функциональными возможностями. *Синегуб Н. И., Ситников В. С.*

4

**Вопросы приборостроения**

Алгоритм оценки состояния эргатических систем управления. *Скубилин М. Д., Стефаненко В. К., Финаев В. И.*

1

**Сенсоэлектроника**

Исследование влияния электронного облучения на кремниевые тензорезисторы. *Дружинин А. А., Марьямова И. И., Кутраков А. П., Лях-Кагуй Н. С., Маслюк В. Т., Мегела И. Г.*

1

Вихретоковый анизотропный термоэлектрический первичный преобразователь лучистого потока. *Ащеулов А. А., Бучковский И. А., Величук Д. Д., Романюк И. С.*

1

Системы контроля-мониторинга температуры и влажности среды на основе толстых пленок оксидов металлов. *Вакив Н. М.*

1

Оптоэлектронные сенсоры газов на основе многоэлементных источников ИК-излучения. *Кабачий В. Н.*

3

Применение ионоселективных полевых транзисторов для ферментного анализа токсичных примесей в водных растворах. *Павлюченко А. С., Кукла А. Л., Голтвянский Ю. В.*

3

Датчики интегральной поглощенной дозы ионизирующего излучения на основе МОП-транзисторов. *Перевертайло В. Л.*

5-6

**Функциональная микро- и наноэлектроника**

Ртутный микрзонд для исследования локальных электрофизических свойств полупроводниковых структур. *Попов В. М., Клименко А. С., Поканевич А. П., Шустов Ю. М.*

1

Получение арсенид-галлиевых структур силовых биполярных и полевых транзисторов методом газофазной эпитаксии. *Воронин В. А., Губа С. К., Курило И. В.*

2

Локальные свойства электрически активных дефектов в солнечных батареях на основе кремния. *Попов В. М., Клименко А. С., Поканевич А. П., Шустов Ю. М., Гаврилюк И. И., Панин А. И.*

4

Физико-технологические аспекты создания низковольтных ограничителей напряжения на основе кремния. *Рахматов А. З., Скорняков С. Л., Каримов А. В., Ёдгорова Д. М., Абдулхаев О. А., Бузруков У. М.*

5-6

**Обеспечение тепловых режимов**

Исследование режимов теплообмена в пульсационной тепловой трубе. *Кравец В. Ю., Наумова А. Н., Вовкогон А. Н.*

1

Исследование характеристик щелевого теплообменника с развитой поверхностью теплообмена. *Малкин Э. С., Николаенко Ю. Е., Дьячков М. И., Николаенко Т. Ю.*

2

Контурная тепловая труба для систем обеспечения тепловых режимов элементов радиоэлектронной техники. *Хайрнасоев С. М.*

3

Влияние на теплопередачу в пульсационной тепловой трубе ее ориентации в пространстве. *Наумова А. Н., Кравец В. Ю.*

5-6

**Технологические процессы и оборудование**

Метод защиты поверхности расплавленного припоя от окисления. *Курмашев Ш. Д., Лавренова Т. И., Бугаёва Т. Н.*

1

Микроволновая обработка диэлектрических материалов в нерезонансных системах. *Демьянчук Б. А.*

2

Волоконно-оптические демультиплексоры для систем передачи информации. *Дементьев С. Г., Ключник Н. Т., Кузнецов В. А., Яковлев М. Я.*

2

Тенденции развития средств создания и анализа безмасляного вакуума. *Васильев Ю. К., Нестеров С. Б., Васильева Т. С.*

2

Широкоапертурный высокочастотный источник ионов низкой энергии с электронной компенсацией. *Дудин С. В., Рафальский Д. В., Зыков А. В.*

2

Фотоэлектростимулированная пассивация спектрометрических  $Cd_{1-x}Zn_xTe$ -детекторов. *Загоруйко Ю. А., Христьян В. А., Федоренко О. А.*

2

Получение активных слоев InP в составе гетероструктур для диодов Ганна. *Вакив Н. М., Круковский С. И., Заячук Д. М., Михащук Ю. С., Круковский Р. С.*

3

Выбор микропривода механизма зажима и подачи проволоки в установках термовзвучивающей микросварки. *Ланин В. Л., Петухов И. Б., Шевцов В. В.*

3

Оптимизация струйной технологии изготовления токопроводящих элементов печатных плат. *Лесюк Р. И., Бобицкий Я. В., Котлярчук Б. К., Иппек В.*

4

Радиационная технология улучшения омических контактов к элементам электронной техни-

ки. *Конакова Р. В., Колядина Е. Ю., Матвеева Л. А., Нелюба П. Л., Шинкаренко В. В.* Технология сборки микросхем на гибком полиимидном носителе. *Плис Н. И., Вербицкий В. Г., Жора В. Д., Волнистов В. Н., Грунянская В. П., Сергеева Н. Н.*

**Материалы электроники**

Термостабильные интерференционные оксидные покрытия для активных элементов лазеров ИК-диапазона. *Загоруйко Ю. А., Федоренко О. А., Коваленко Н. О., Кузьминов Е. А., Матейченко П. В.*

Оптико-акустические эффекты в решетчатых упаковках (опаловые матрицы как метаматериал). *Чернега Н. В., Кудрявцева А. Д., Самойлович М. И., Белянин А. Ф., Клещева С. М.* Стабильность свойств пьезокерамических материалов при внешних воздействиях. *Кузенко Д. В., Бажин А. И., Дорофеева В. В., Гусакова Л. Г., Ищук В. М., Спиридонов Н. А.*

Газочувствительные элементы на основе пленок SiPcCl<sub>2</sub>. *Алиева Х. С., Сулейманов С. С., Муршудли М. Н.*

Диагностика глубоких центров на границе пленка-подложка в тонкопленочных эпитаксиальных структурах GaAs. *Горев Н. Б., Коджеспирова И. Ф., Привалов Е. Н.*

Молекулярная модель и химическая связь теллура. *Ащеулов А. А., Маник О. Н., Маник Т. О., Билинский-Слотыло В. Р.*

Электрические и топологические свойства пленок оксидов, термически выращенных на подложках InSe. *Катеринчук В. Н., Ковалюк З. Д., Хомяк В. В.*

5-6 Свойства и практическое применение нанокристаллических пленок оксида церия. *Максимчук Н. В., Шмырева А. Н., Борисов А. В.* 5-6  
 5-6 Свойства металлических контактов на пленках TiO<sub>2</sub>, изготовленных методом реактивного магнетронного распыления. *Брус В. В., Ковалюк З. Д., Марьянчук П. Д., Орлецкий И. Г., Майструк Э. В.* 5-6

1 Исследование стойкости слоев поликремния в КНИ-структурах при воздействии электронного облучения и сильного магнитного поля. *Ховерко Ю. Н.* 5-6

1 Зависимость диэлектрической проницаемости кристаллизующейся фазы стеклокерамики от времени спекания. *Дмитриев М. В., Еримичой И. Н., Панов Л. И.* 5-6

**Метрология. Стандартизация**

1 Уменьшение влияния пиротехнических зарядов на работу измерительных усилителей. *Старцев В. И., Ямпольский Ю. С., Куценко А. П.* 3

**К истории науки и техники**

2 80 лет со дня основания Московского энергетического института. *Богатырев Е. А., Смольский С. М.* 2

4 Становление и развитие Института физики полупроводников им. В. Е. Лашкарёва НАН Украины (к пятидесятилетию создания). *Мачулин В. Ф.* 4

**Библиография**

5-6 Указатель статей, опубликованных в журнале в 2009 г. 1